

КТ814А,Б,В,Г

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ
ТРАНЗИСТОР**

аАО. 336.184 ТУ / 02

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В КЛЮЧЕВЫХ И ЛИНЕЙНЫХ СХЕМАХ, УЗЛАХ И БЛОКАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

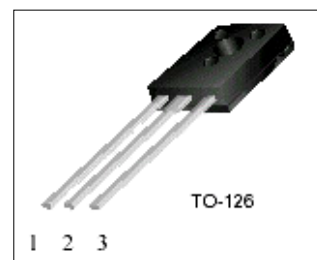
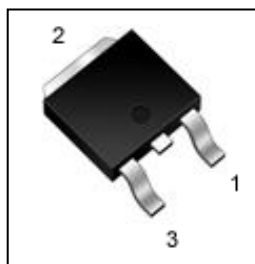
* Зарубежный аналог:

**КТ814Б-ВD136, КТ814В-ВD138,
КТ814Г-ВD140, КТ814А-отсутст.**

* Изготавливается в корпусе

КТ-27 (ТО-126)

КТ-89 (ДРАК)



1 - эмитт. 2 -колл. 3 - база

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер ($R_{эб} \leq 100 \text{ Ом}$)	КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г	Uкэ max	В 40 50 70 100
Напряжение эмиттер-база		Uэб max	В 5
Постоянный ток коллектора		Iк max	А 1.5
Импульсный ток коллектора		Iки max	А 3
Максимально допустимый постоянный ток базы		Iб max	А 0,5
Рассеиваемая мощность коллектора		Pк max	Вт 10
Температура перехода		Tпер	°С 150

Диапазон рабочих температур среды от -60 до +125°С

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Tокр.ср.=+25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение колл-эмит	КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г	Uкэо гр.	Iэ=50mA, ti=0.3÷1 мс	30 45 65 85	
Обратный ток коллектора	КТ814А, Б КТ814В, Г	Iкбо	мкА		Uкэ=50 В Uкэ=65 В 50 50
Обратный ток коллектор-эмиттер	КТ814А, Б КТ814В, Г	Iкэг	мкА		Uкэ=50 В, Rбэ≤100 Ом Uкэ=65 В, Rбэ≤100 Ом 100 100
Статический коэффициент передачи тока	КТ814А ÷В КТ814Г	h _{21э}		40 30	275 275
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер		Uкэ нас	В		Iк=0.5 А, Iб=50 мА 0,6

220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail:market@transistor.com.by; http://www.transistor.by